

請求の範囲

- [請求項1] 表面金属濃度が15.0ppwt以下であり、該表面金属濃度のうち、表面タングステン濃度が0.9ppwt以下であり、且つ表面コバルト濃度が0.3ppwt以下である、ことを特徴とする多結晶シリコン破碎塊。
- [請求項2] 表面金属濃度が7.0～13.0ppwtであり、該表面金属濃度のうち、表面タングステン濃度が0.40～0.85ppwtであり、且つ表面コバルト濃度が0.04～0.08ppwtである、請求項1記載の多結晶シリコン破碎塊。
- [請求項3] 多結晶シリコン破碎塊が、多結晶シリコンロッドを、打撃部の材質が、炭化タングステン／コバルト合金からなる破壊具により破碎して得たものである、請求項1または請求項2記載の多結晶シリコン破碎塊。
- [請求項4] 前記表面金属濃度がNa, Mg, Al, K, Ca, Cr, Fe, Ni, Co, Cu, Zn, W, TiおよびMoの合計濃度である、請求項1～3のいずれか一項記載の多結晶シリコン破碎塊。
- [請求項5] 請求項1～4のいずれか一項に記載の多結晶シリコン破碎塊が、樹脂製袋に収納されてなる、多結晶シリコン破碎塊梱包体。
- [請求項6] a) 多結晶シリコンロッドの破碎工程、
b) 得られた多結晶シリコンロッドの破碎塊をフッ硝酸水溶液と接触させる第一洗浄工程、
c) 第一洗浄工程を経た多結晶シリコン破碎塊の洗浄物を、過酸化水素を含むアルカリ水溶液と接触させる第二先洗浄工程
d) 第二洗浄工程を経た多結晶シリコン破碎塊の洗浄物を、フッ硝酸水溶液と接触させる第三先洗浄工程
を含んでなる、請求項1記載の多結晶シリコン破碎塊の製造方法。
- [請求項7] c) 第二洗浄工程において、過酸化水素を含むアルカリ水溶液に溶解されたアルカリ性物質が、テトラメチルアンモニウムヒドロキシドで

ある、請求項6記載の多結晶シリコン破碎塊の製造方法。

[請求項8] a) 多結晶シリコンロッドの破碎工程において、その破碎に、打撃部の材質が、炭化タングステン／コバルト合金からなる破壊具が使用されてなる、請求項6または請求項7記載の多結晶シリコン破碎塊の製造方法。

[請求項9] b) 第一洗浄工程における、各多結晶シリコン破碎塊表面のエッチング代が1.5～10.0 μm である、請求項6～8のいずれか一項に記載の多結晶シリコン破碎塊の製造方法。